

InGaAs фотодиод 2600 нм, 1000 мкм, ТО-корпус — техническое описание

P/N : WIT5-1000G

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая чувствительность
- Низкий темновой ток
- Спектральная чувствительность 900–2600 нм

ПРИМЕНЕНИЕ

Датчики СО; оптические датчики; измерители оптической мощности; измерение спектральной чувствительности

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Ед. изм.	Мин.	Макс.
Рабочая температура	T _{STG}	°C	-40	85
Температура хранения	T _C	°C	-40	85
Температура (время) пайки	T _L	°C		260 / 10 с

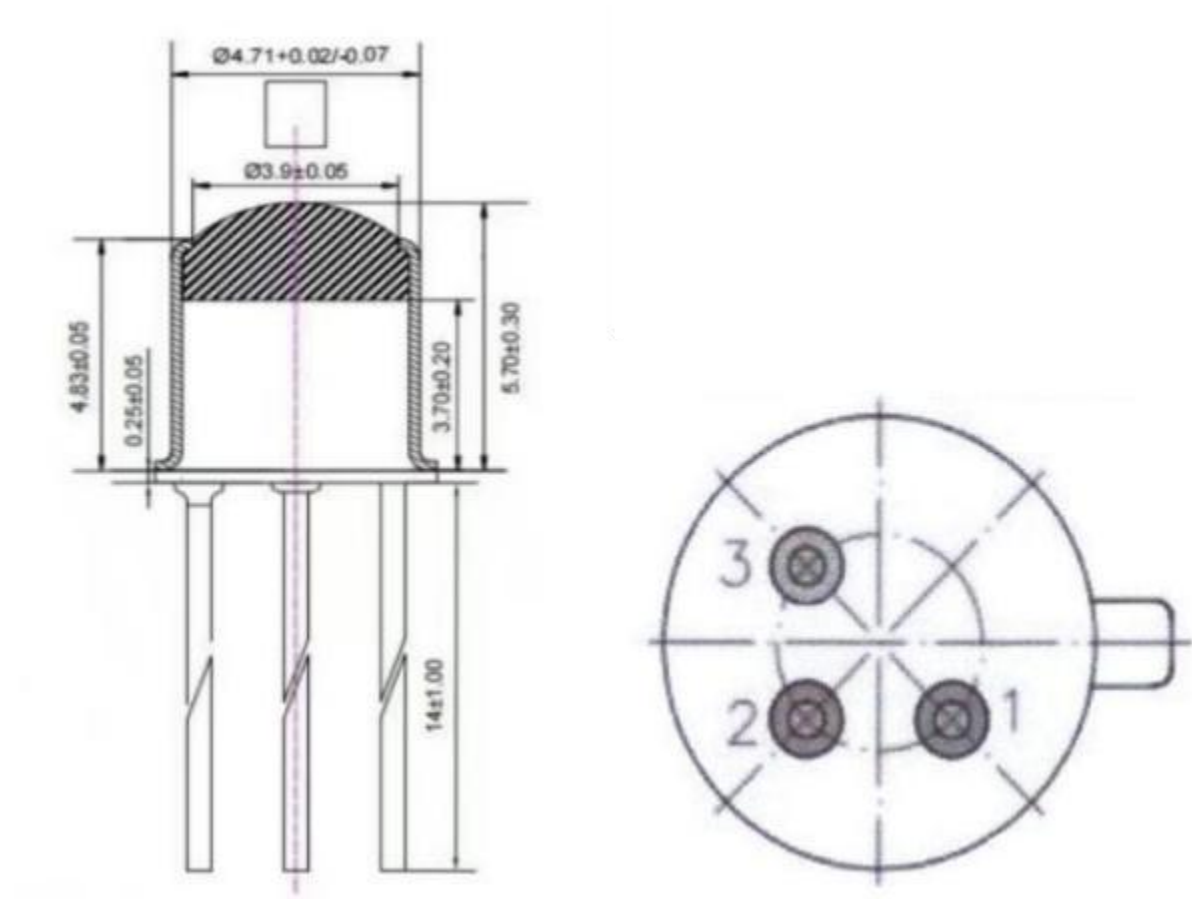
Электрооптические характеристики (T=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	D	-	995	1000	1005	мкм
Чувствительность	R	Vr = 0V, @2300 nm	0.9	1.0	-	А/Вт
Темновой ток	ID	Vr = -0.5V	-	-	50	мкА
Спектральная чувствительность	λ	-	900	2330	2600	нм
Емкость	C	Vr = 0V, f = 1MHz		440	1000	пФ

ПРИМЕЧАНИЕ:

При хранении, транспортировке и использовании рекомендуются соответствующие меры защиты от ЭСР.

Назначение выводов и габаритный чертёж:



№ вывода	Название
1	PD+
2	PD-
3	GND